面内磁気異方性を持つエピタキシャル RCo5 規則合金膜の構造解析

堀田裕介・山田真・鈴木中・大竹充・二本正昭・桐野文良^{*}・稲葉信幸^{**} (中央大,^{*}東京藝大,^{**}山形大)

Structural Characterization of *R*Co₅ Ordered Alloy Epitaxial Thin Films with In-plane Magnetic Anistropies Yusuke Hotta, Makoto Yamada, Ataru Suzuki, Mitsuru Ohtake,

Masaaki Futamoto, Fumiyoshi Kirino*, and Nobuyuki Inaba**

(Chuo Univ., *Tokyo Univ Arts, **Yamagata Univ.)

はじめに 希土類金属(*R*) と3*d* 強磁性遷移金属のCoからなる*R*Cos 規則合金は高い*K*^a 特性を示し,その 薄膜は薄膜磁石,アクチュエータ,マイクロモータなどへの応用に向けた研究が行われている.これまで, (100)もしくは(211)配向のW¹⁾やCr²⁾, Fe³⁾などのbcc金属下地層を用いることにより,*c*軸が面内に存在す るエピタキシャルSmCos膜の形成が報告されている.本研究では,MgO単結晶基板上にヘテロエピタキシ

ャル成長させたCr(100)およびCr(211)下地層上に 種々の希土類元素を用いた*R*Cos規則合金膜の形 成を行い,膜形成条件と膜構造の関係を調べた.

実験方法 膜形成には超高真空分子線蒸着装置 を用いた. MgO(100)および MgO(110)基板上に, それぞれ, ヘテロエピタキシャル成長させた Cr(100)および Cr(211)下地層上に 20 nm 厚の R と Co の組成比が 1:5 となる組成で基板温度 500 ℃ で膜形成した.構造評価には RHEED および XRD, 磁気特性評価には VSM を用いた.

実験結果 Fig. 1(a)および(b)に Cr(100)下地層上 に Sm-Co 膜形成中に観察した RHEED パターン を示す.形成初期段階から製膜後まで,Fig. 1(d) の SmCo₅(1120)表面の形成を示す回折パターンが 観察されており,エピタキシャル SmCo₅ 膜が得 られていることが分かる.RHEED 解析により決 定したエピタキシャル方位関係は以下の通りで ある.

$SmCo_5(11\overline{2}0)[0001] \parallel Cr(100)[011]$ $SmCo_5(11\overline{2}0)[1\overline{1}00] \parallel Cr(100)[011]$

SmCo₅ 膜は, *c* 軸が面内に存在し,互いに直交し た方位関係を持つ 2 つのバリアントから構成さ れていることが分かった. Fig. 2 に XRD パター ンを示す.面外パターンでは,SmCo₅(1120)反射 が認められる.面内パターンでは,SmCo₅(0002) 基本反射に加え,SmCo₅(0001)超格子反射も観察 されており, RT_5 型構造に規則化した SmCo₅膜が 形成されていることが分かる.当日は Sm 以外の R元素を用いた RCo_5 膜についても報告する.

参考文献 1) E. E. Fullerton *et al.: Appl. Phys. Lett.*, **69**, 2438 (1996). 2) E. E. Fullerton *et al.: Appl. Phys. Lett.*, **71**, 1579 (1997). 3) M. J. Pechan *et al.*, *J. Appl. Phys.* **87** 6686 (2000).



Fig. 1 (a, b) RHEED patterns observed during Sm-Co deposition on Cr(100) underlayer at 500 °C. The Sm-Co film thicknesses are (a) 5 and (b) 20 nm. (c–f) Schematic diagrams of RHEED patterns simulated for (1120) surfaces of (c) $\text{Sm}_2\text{Co}_{17}$, (d) SmCo_5 , (e) Sm_2Co_7 , and (f) SmCo_3 crystals.



Fig. 2 (a) Out-of-plane and (b) in-plane XRD patterns of an Sm-Co film deposited on Cr(100) underlayer at 500 °C.